



グローバル COE 物質科学イノベーション講演会

演題：FZ 法による高融点単結晶の育成

講師：大谷茂樹 先生

(独)物質・材料研究機構

光・電子材料ユニット

光・電子機能グループ 主席研究員

日時：2012年2月29日(水) 16:00~17:00

場所：工学部材料・化学棟 5F 大会議室 (MC526)

要旨：

ルツボを使用しない浮遊帯域溶融(FZ)法は、比較的大型の高融点結晶の作製に最適である。最近、フラックスを用いることで結晶が良質化している。講演では、結晶育成の進展と結晶に関わるトピックスを紹介する。

連絡先：工学研究院物質化学部門 吉川信一 (内線：6739)